



SEMIPACK® Fast Thyristor/Diode Modules

isolated metal bases. $V_{iso1} = 2500\text{ V}$

SEMIPACK® Schnelle Thyristor/Dioden- Module

SEMIPACK® Modules à thyristors/diodes rapides

Types ¹⁾ All data apply to one single valve device (thyristor or diode)	V_{DRM} V	V_{RRM} V	I_{TRMS} I_{FRMS} A	$I_{TAV}^{(2)}$ $I_{FAV}^{(2)}$ (T_{case}) A	I_{TSM} I_{FSM} 25 °C 10 ms A	I^2t 25 °C 10 ms A ² s	$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{cr}$ V/μs	V_T, V_F max. (I_T, I_F) V	$V_{T(TO)}$ $V_{F(TO)}$ V	r_T mΩ	t_T 25 °C μs	t_d 125 °C μs	V_{GT} min. ($t_p = 100\text{ μs}$) V	I_{GT} min. ($t_p = 100\text{ μs}$) mA
SKFA® 18/08 CP /08 CP /10 CP /11 CP /12 CP	600 800 1000 1100 1200	10	36	17 (80 °C) 50 Hz	350	610	200	2,5 (70 A)	1,4	12	0,3	5	3	200
SKFH 20/08 DS /10 DS; DT /12 DT; DU	800 1000 1200	800 1000 1200	45	20 (85 °C)	550	1500	500	2,5 (150 A) 125 °C	1,7	5,5	1	15 15; 20 20; 25	3	200
SKFH 30/08 DT /10 DT /12 DT	800 1000 1200	800 1000 1200	75	30 (89 °C)	1000	5000	500	2,25 (150 A) 125 °C	1,6	4	1	20	3	200
SKFH 40/08 DS; DU /10 DT; DU /12 DT; DU	800 1000 1200	800 1000 1200	110	40 (87 °C)	1300	8400	500	2,3 (200 A) 125 °C	1,8	2	2	15; 25 20; 25 20; 25	3	200
SKFH 60/08 DS /10 DT /12 DT; DU	800 1000 1200	800 1000 1200	130	60 (81 °C)	1500	11250	500	1,75 (200 A) 125 °C	1,5	1,5	2	15 20 20; 25	3	200
SKFH 110/04 DS; DT /08 DS; DT /10 DS; DT /12 DU	400 800 1000 1200	400 800 1000 1200	250	110 (85 °C)	4500	101000	500	1,85 (400 A) 125 °C	1,45	1	2	15; 20 15; 20 15; 20 25	4	250
SKFH 150/06 DS /08 DS /09 DS /10 DS	600 800 900 1000	600 800 900 1000	385	150 (85 °C)	6500	210000	500	2,05 (1200 A)	1,4	0,5	—	15	5	250
SKAH® 180/12 DS /14 DS	1200 1400	15	385	180 (80 °C)	8000 (8,3 ms)	265000	500	2,2 (1200 A)	1,4	0,4	—	15	5	250
SKFT 20/06 DS; DT /08 DS; DT /10 DS; DT /12 DT; DU	600 800 1000 1200	600 800 1000 1200	45	20 (85 °C)	550	1500	500	2,5 (150 A) 125 °C	1,7	5,5	—	15; 20	3	200
SKFT 30/06 DS; DT /08 DS; DT /10 DS; DT /12 DT; DV	600 800 1000 1200	600 800 1000 1200	75	30 (89 °C)	1000	5000	500	2,25 (150 A) 125 °C	1,6	4	—	15; 20 15; 20 15; 20 20; 30	3	200
SKFT 40/08 DS; DU /10 DT; DU /12 DT; DU	800 1000 1200	800 1000 1200	110	40 (87 °C)	1300	8400	500	2,3 (200 A) 125 °C	1,8	2	—	15; 20 20; 25 20; 25	3	200
SKFT 60/08 DS; DT /10 DT /12 DT; DU /14 DU	900 1000 1200 1400	800 1000 1200 1400	130	60 (81 °C)	1500	11250	500	1,75 (200 A) 125 °C	1,5	1,5	—	15; 20 20 20; 25 25	3	200
SKFT 110/04 DS; DT /08 DS; DT /10 DS; DT /12 DU /14 DU	400 800 1000 1200 1400	400 800 1000 1200 1400	250	110 (85 °C)	4500	101000	500	1,85 (400 A) 125 °C	1,45	1	—	15; 20 15; 20 15; 20 25 25	4	250
SKKD 40 F04 F06 F08 F10	— — — —	400 600 800 1000	110	40 (80 °C)	1100	6000	—	2,0 (150 A)	1,2	4	0,2	—	—	—
SKKD 40 M08 M12 M14 M15	— — — —	800 1200 1400 1500	110	40 (83 °C)	800	3200	—	1,85 (150 A)	1,0	5	1	—	—	—
SKKD® 50 E01 E03 E04	— — —	100 300 400	110	50 (81,5 °C)	800	3200	—	1,6 (120 A)	0,8	6,5	0,06	—	—	—
SKKD 160 M08 M10 M12 M14 M15	— — — — —	800 1000 1200 1400 1500	300	160 (86 °C)	7000	245000	—	1,5 (400 A)	1,25	0,5	2	—	—	—
SKLD 20 F04 F06 F08 F10	— — — —	400 600 800 1000	40	15,2 (85 °C)	450	1000	—	2,15 (50 A)	1,3	12	0,2	—	—	—

1) Second code letter appended to the type number:

P: $t_q \leq 7\text{ μs}$ (gate-assisted turn-off. $V_G = -10\text{ V}$)

S: $t_q \leq 15\text{ μs}$ · T: $t_q \leq 20\text{ μs}$

U: $t_q \leq 25\text{ μs}$ · V: $t_q \leq 30\text{ μs}$

2) $f \leq 500\text{ Hz}$

3) Internal insulation: beryllium oxide

4) Epitaxial diodes

5) Asymmetric thyristors

